

國立交通大學

電機資訊學院 電子與光電學程

碩士論文

矽化金屬互補式金氧半導體製程之新型靜電

放電防護元件



New ESD Protection Devices with Dummy-Gate

Structure in a Fully-Salicided CMOS

Technology

研究生：陳啟銘

指導教授：柯明道 教授

中華民國九十三年六月

矽化金屬互補式金氧半導體製程之新型靜電
放電防護元件

New ESD Protection Devices with Dummy-Gate Structure in a
Fully-Salicided CMOS Technology

研究生：陳啟銘

Student : Chi-Ming Chen

指導教授：柯明道 教授

Advisor : Prof. Ming-Dou Ker

國立交通大學

電機資訊學院 電子與光電學程



Submitted to Degree Program of Electrical Engineering and Computer Science

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Electronics and Electro-Optical Engineering

June 2004

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月

授權書

(博碩士論文)

本授權書所授權之論文為本人在交通大學(學院)電機資訊學院電子與光電學程系所

九十二學年度第二學期取得碩士學位之論文。

論文名稱：矽化金屬互補式金氧半導體製程之新型靜電放電防護元件

1. 同意 不同意

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予行政院國家科學委員會科學技術資料中心、國家圖書館及本人畢業學校圖書館，得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或數位化等各種方式重製後散布發行或上載網路。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利的附件之一，請將全文資料延後兩年後再公開。(請註明文號：)

2. 同意 不同意

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予教育部指定送繳之圖書館及本人畢業學校圖書館，為學術研究之目的以各種方法重製，或為上述目的再授權他人以各種方法重製，不限地域與時間，惟每人以一份為限。

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未鈎選，本人同意視同授權。

指導教授姓名： 柯明道

研究生簽名： 陳啟銘

(親筆正楷)

學號：8967515

(務必填寫)

日期：民國 93 年 6 月 17 日

-
1. 本授權書請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。
 2. 授權第一項者，所繳的論文本將由註冊組彙總寄交國科會科學技術資料中心。
 3. 本授權書已於民國 85 年 4 月 10 日送請內政部著作權委員會（現為經濟部智慧財產局）修正定稿。
 4. 本案依據教育部國家圖書館 85.4.19 台(85)圖編字第 712 號函辦理。